# Display向け量子ドットレジストの開発

住友化学株式会社 情報電子化学品研究所

7 IANT-EALAR	産業と技術革新の 基徴をつくるう	<b>11</b> 住み続けられる オキベイリタ
		₽A
		<b>AH</b> H

## はじめに

量子ドットは、Fig. 1(a)に示すように、Quantum Dot Enhancement Film (QDEF) と呼ばれる液晶ディ スプレイ (LCD) のバックライトの直上に配置され る色変換シートを中心に、ディスプレイの広色域化 に不可欠な材料として注目を集めてきた<sup>1),2)</sup>。このよ うに、量子ドットは、ディスプレイ分野では主に 「色変換」機能を活用されることが多い。これは量子 ドットの持つユニークな特徴の一つである「青の光 を吸収して、鮮やかな緑や赤の光を発光する| 性質 を利用したものである。QDEF技術においては、バッ クライト光源に青色LEDのみを用い、この青の光を QDEFに通すことによって一部を緑と赤に変換し、青 色(元の光源色)、緑色、赤色が混ざった「白色バッ クライト」を実現している。このようにして得られた 発光スペクトルは、通常の白色LEDに用いられる蛍 光体の発光に比べると半値幅が狭く、非常にシャープ であるため単色性に優れたものとなっている。量子 ドットはその粒子サイズにより発光波長を任意に選 択可能であり、緑や赤の発光中心波長を適切に設計 することで、「色再現できる範囲が広い」、いわゆる 広色域ディスプレイを実現できるのである<sup>1),2)</sup>。

近年ではFig. 1(b)に示すように、量子ドットを用い たQuantum Dot Color Conversion(QDCC)と呼ばれ る技術が注目を集めており、広色域化のメインストリー ムとして検討が盛んに行われている<sup>3)-6)</sup>。この技術で は、有機EL(OLED)ディスプレイなどにおいて、従来 型のカラーフィルターの位置に、QDCC層がパターン 配置される構成をとる。すべてのサブピクセルに青色 の発光層(光源)を用いた上で、赤の画素および緑の 画素はQDCC層によって青色の光源の光をそれぞれ 緑、赤に変換して表示し、青の画素は青色光源の光を そのまま表示に用いることが特徴である。通常のOLED 発光素子(緑や赤)の発光に比べて、量子ドットの発 光スペクトルはよりシャープであることから、QDCC 技術はOLEDの広色域化に大きく寄与をしている。



Fig. 1 Cross-sectional schematics of (a) QDEF with LCD, (b) (c) QDCC with OLED and micro LED, respectively

\* 現所属:情報電子化学業務室

さらには、Fig. 1(c)に示すように、micro LEDディ スプレイと呼ばれる次世代のディスプレイ開発が進 んできており、このQDCC技術はmicro LEDディスプ レイのフルカラー化にも大きく寄与することが期待 されている。このmicro LEDディスプレイは、数ミク ロンサイズの極小LEDを並べたアレイにより表示を 行うディスプレイであるが、低コストで青、緑、赤す べての極小LEDを画素に作り込むことが非常に難し い。このため、青色LED一色のモノリシックmicro LEDディスプレイを形成した上で、QDCC技術を用 いてフルカラー化を達成しようとする流れが大きな トレンドとなっている<sup>7</sup>。

# 量子ドットのレジスト化

住友化学株式会社では、古くから、液晶ディスプ レイのカラーフィルターに用いるカラーレジスト (染料・顔料を含有させたレジスト材料)の量産およ び新規材料開発を継続して実施してきた。筆者らは、 このカラーレジスト技術をベースとして、QDCC技 術の一つである「量子ドットレジスト」の研究開発 を行っている。

量子ドットのレジスト化においてカラーレジストと 大きく異なる点は、通常の顔料のサイズ(50nm以上) と比べて、量子ドットの粒子サイズ(10 nm未満)が 非常に小さいという点である。サイズが小さいと、 Fig. 2に示すように体積に対する表面積の割合が非常



Fig. 2 Relation between specific surface area and particles size. The diameters of QD are much smaller than those of pigments, which indicates that QD more easily aggregates due to its instability from large surface energy.

に高くなり、表面エネルギーが不安定化する。その 結果、容易に凝集して安定化を図ろうとすることか ら、量子ドットは「非常に凝集しやすい材料」であ ると言える。加えて、量子ドット同士が凝集すると 粒子間でのエネルギー移動が容易に起こるようにな り、微量に存在する欠陥準位からほとんどのエネル ギーがリークして失活してしまう問題を生じる。こ のため、この非常に凝集しやすいナノサイズの粒子 を「いかに自己凝集させずに最終形態まで保持する か」が重要な技術課題となる。

Fig. 3に示すのは、一連のレジストプロセス(塗 布、乾燥、露光、現像、ポストベーク)を通して得 られた量子ドットレジスト膜のTEM断面像である。 Fig. 3(a)に示すように、レジスト材料および量子 ドット表面の構造を最適に設計せずにレジストプロ セスを通すと、量子ドットの著しい凝集を生じ、発 光がほとんど消失してしまう結果となった。また、 Fig. 3(b)に示すのは、初期の分散状態が最適になる ように、レジスト構造と量子ドット表面の構造を設 計したものであるが、初期の分散は良好であっても、 レジストプロセス (特にポストベーク時の熱) に



Cross-sectional TEM images of patterned films after post-baking. (a) Fully aggregated QDs with no structural optimization. (b) Partially aggregated QDs with optimized only considering initial dispersion. (c) Well-dispersed QDs with fully-optimized chemical structure of both QD surface and photoresist, considering high temperature durability. (d) Schematic of energy deactivation of QDs due to aggregation.

よって再凝集が起こってしまい、発光特性が低下す ることが分かった。Fig. 3(c)に示すのは、耐久性 (耐熱性)まで踏まえて分子構造設計したレジスト材 の結果であるが、レジストプロセスを経ても良好な 分散状態を保っていることが分かる。

これらの結果から分かるように、量子ドットの表 面およびレジスト材料の適切な設計によって、「分散 性」および「耐熱性」を同時に付与することができ、 最終塗膜においても良好な分散状態が得られる量子 ドットレジストを開発することができた。

## 量子ドットレジストの特性

Fig. 4に示すのは、Fig. 3(c)の分散状態の塗膜について光学特性を測定した結果である。良好な分散状態の塗膜を得ることで、レジストプロセス後においても、赤で量子収率(QY)70%以上、緑においても60%以上の特性を達成することに成功した。また、半値幅(FWHM)も緑で37 nm程度、赤においても38 nm程度と非常に狭い値を示し、単色性の高い発光ス



		Green	Red
Thickness	(µm)	10	10
Optical density		0.60	0.82
Quantum yield	(%)	62	72
λpeak	(nm)	543	640
FWHM	(nm)	37	38

Fig. 4 Emission spectra (top) and optical properties (bottom) of red and green QDPR films with 10 µm thickness. QY, λ<sub>peak</sub>, and FWHM in the bottom table indicate internal quantum efficiency based on number of photons, peak wavelength of emission, and full-width-half-maximum of emission, respectively.



Fig. 5

Optical images of (a) green QDPR and
(b) red QDPR patterned features on glass. Numbers on the top indicate line width (µm). SEM images of (c) top-view and (d) cross-sectional view on these patterned subpixels.

ペクトルが得られていることが分かった。Fig. 4上に 載せたスペクトルにおいては、変換されなかった青 の励起光も一部残っているが、これらを(QD層の上 に配置する)カラーフィルター層によって取り除く ことで、高い色純度のピクセルを形成することがで きる。

また、Fig. 5(a)および(b)に示すのは、開発した量 子ドットレジストを用いてストライプ形状を形成し た時の平面視での光学画像を示したものである。 Fig. 5(a)緑、(b)赤ともに30 µmレベルまできれいに パターンが形成できていることが分かる。また、 Fig. 5(c)および(d)に示したのはかかるストライプ形 状の断面SEM画像を示したものである。こちらも良 好なテーパー形状を示し、30 µmレベルまでの解像度 に問題がないことが分かる。なお、解像度に関して は露光装置などの設備に依存する部分が大きいため、 当社ラボでの試験は30 µm付近にとどまっているが、 より高性能な露光装置を用いることで10 µm以下のレ ベルまでパターン形成を行うことが可能であること を確認済みである。

#### 量子ドットレジストの耐久性

**Fig. 6**に示すのは、量子ドットレジストを用いてレジストプロセスを通して形成した塗膜について、耐久性試験を行った結果である。試験に用いたサンプル



Fig. 6Stability test results for red and green<br/>encapsulated QDPR films at (a) 80 °C dry<br/>and (b) 60 °C 90%RH for up to 1000 hrs

について、酸素や水蒸気の影響をなくすために量子 ドットレジスト層の上に市販のバリア層(フィルム) を貼合して試験を行った。その結果、バリア層を用 いることで、1000時間まで良好な発光特性を維持で きることが分かった。

#### 今後の展開

上述のように広色域化のキー技術である量子ドッ トを用いたレジスト材料を開発、紹介してきた。そ の中でも、世の中の要求事項として根強いのは、さ らなる光学特性の向上である。特に青色光源の吸収 のさらなる向上が望まれており、現在、これに向け て材料メーカーと共に改良に取り組んでいるところ である。

#### 引用文献

- 春澤文久,映像情報メディア学会誌,70,420 (2016).
- 2) J. Hartlove, LEDs Magazine Japan, 2011年12月号, 14 (2011).
- 清都 育郎, J. Jpn. Soc. Colour Mater., 92(6), 158 (2019).
- 4) A. Ishizuka *et al.*, IDW '18, Meeting 5-1: Invited Paper (Dec 2018).
- 5) E. Lee *et al.*, SID Symposium Digest of Technical Papers, 48, Issue 1, 984 (2017).
- 6) T. H. Kim et al., Nat. Photonics, 5, 176 (2011).
- 7) B. Boerger and N. V. Wyck, "Rapid Assembly of Quantum Dots for MicroLED Micro-Displays, Nov. 23, 2017", LED inside of TrendForce Corp, https://www.ledinside.com/knowledge/2017/11/ rapid\_assembly\_of\_quantum\_dots\_for\_microled\_ micro\_displays (参照 2020/3/24).